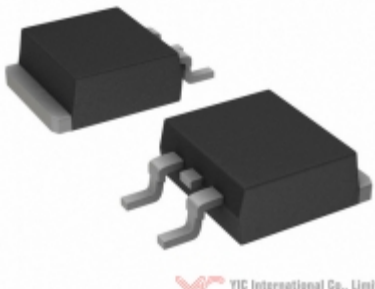


	FQB55N06TM	
	Hersteller-Teilenummer:	FQB55N06TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 55A D2PAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQB55N06TM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 60725 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQB55N06TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 55A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	60725 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 55A (Tc) 3.75W (Ta), 133W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 133W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	55A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 27.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1690pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQB55N06TM ist neu im Original, Suche FQB55N06TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB55N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB55N06TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB50N10 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p>FQB55N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 55A D2PAK</p>	 <p>FQB52N25 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p>FQB5N15 Fairchild/ON Semiconductor FQB5N15 FAIRCHILD</p>
 <p>FQB5N15TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 5.4A D2PAK</p>	 <p>FQB50N06TM-NL VB FQB50N06TM-NL VB</p>	 <p>FQB50N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A D2PAK</p>	 <p>FQB55N10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 55A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited